

デバイス試作、プロセス・材料開発/評価/試験

～試作実験レベルから試作評価レベルまで、多様な研究・開発ニーズに対応可能な施設～

▶デバイスメーカーとの連携連携入り込によるウェハレベル試作 (1μm角程度のチップサイズから 200mmウェハまでフレキシブルに対応可能)

▶新選材料、新設プロセスのデバイスレベル評価 (PM diode, MOS capacitor, MOSFET, Antenna-MOS, TFT, インバータ、リングオシレータ、VCO、テスト回路、等)

▶各種材料・表面処理等に対するプラズマ活性・窒素ガス活性・窒素活性評価およびガスの分析特性評価 (ガス供給系材料、ガス供給系材料、チャンネル材料、電極材料、パッド、セラミック、フッ素プラズマ、塩素系プラズマ、酸素系プラズマ、MOソース、酸・アルカリ処理、等)

▶標準試料・評価用試料の作製 (SOI薄膜、SiN薄膜、Poly-Si薄膜、金属薄膜、ノリコート形成、等)

▶電気特性評価、高温品質評価の開発・評価 (高圧電源装置、低圧電源装置、絶縁層、Leak, ESD、等)

200 mm Wafer Semiconductor Manufacturing Line

